WO 2005/013270 PCT/FR2004/001677

Procédé d'enregistrement de données et dispositif de mise en oeuvre comportant un support de mémoire déformable

Domaine technique de l'invention

5

L'invention concerne un procédé d'enregistrement de données au moyen d'un réseau de micropointes, disposé dans un plan face à un support de mémoire, comportant un empilement de couches minces avec au moins une couche mémoire déformable. Ce procédé comporte l'enregistrement de données par actionnement sélectif des micropointes.

L'invention concerne également un dispositif d'enregistrement de données pour la mise en œuvre du procédé d'enregistrement.

15

10

État de la technique

20

L'enregistrement de données, aussi bien dans le domaine de l'informatique que dans le domaine des multimédias, doit répondre à un besoin croissant de capacité. Différentes techniques ont été développées, allant du disque dur magnétique au DVD utilisant l'optique et des matériaux à changement de phase. Quelle que soit la technique d'enregistrement utilisée, on cherche toujours à réduire la taille des points mémoires (bits) et l'accroissement de la capacité d'enregistrement passe par une augmentation de la dénsité de stockage.

25

Récemment, de très grandes capacités de stockage, de l'ordre du Térabit/cm², ont été obtenues en mettant en œuvre des micro-pointes du type utilisées dans le domaine de la microscopie à effet de pointe (« The Millipede – More than one

thousands tips for future AFM data storage », P. Vettiger et al., IBM J. RES. Develop., vol.44, n° 3, mai 2000, p.323-340 et « Fabrication of microprobe array with sub-100nm nano-heater for nanometric thermal imaging and data storage », Dong-Weon Lee et al., Technical Digest, MEMS 2001, 14th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (Cat. N°01CH37090), IEEE, Piscataway, NJ, USA, 2001, p.204-207). La haute densité est obtenue par localisation des bits au moyen de micro-pointes dont l'apex est de dimension nanométrique. Les micro-pointes sont, de préférence, disposées en réseau bidimensionnel, avec un accès parallèle aux données, ce qui permet d'atteindre d'excellentes performances en ce qui concerne le débit. Un actionneur unique, qui peut être électromécanique, permet un déplacement relatif monolithique de l'ensemble du réseau de micro-pointes par rapport à la surface du média constituant le support de mémoire. L'écriture est ensuite réalisée de façon thermomécanique.

15

10

5

Dans un tel dispositif d'enregistrement de données, avec effet de pointes, il est nécessaire de garantir un parfait contact de toutes les pointes avec le support de mémoire. Pour des raisons de complexité du système, il n'est pas envisageable de contrôler la position de chaque micro-pointe individuellement. Or, les micro-pointes sont fabriquées de manière collective, par des techniques dérivées de celles de la microélectronique, et il reste toujours une dispersion, due à la fabrication, de la hauteur des micro-pointes. Bien que cette dispersion soit minime, typiquement de l'ordre de 100nm, la plus longue des micro-pointes d'un réseau appuie plus que les autres sur le support de mémoire.

25

20

Pour surmonter cette difficulté, chaque micro-pointe est portée en porte-à-faux par une extrémité d'un cantilever, de manière analogue aux réseaux de micro-

pointes utilisés en microscopie à sonde locale. La souplesse du cantilever permet alors d'absorber la contrainte d'un appui.

Les documents WO-A-9744780, EP-A-887794 et le brevet US 6218086 décrivent également des dispositifs d'enregistrement dans lesquels chaque micropointe est disposée à l'extrémité d'un cantilever. La simple mise en contact de la micropointe et du support de mémoire provoque un fléchissement du cantilever, permettant de compenser partiellement la dispersion de la hauteur des micropointes. Pour enregistrer une information, une déformation locale du support de mémoire est provoquée soit thermiquement soit mécaniquement.

5

10

15

20

25

Cependant, les forces d'appui des micro-pointes sur le support de mémoire ne doivent pas excéder une valeur de l'ordre de 100nN par exemple, de manière à ne pas endommager le support de mémoire. En effet, la surface de contact d'une micro-pointe avec le support de mémoire étant minuscule, la pression est importante. Les cantilevers doivent donc être très souples pour absorber la dispersion de hauteur des micro-pointes. À titre d'exemple, des cantilevers ayant une raideur de l'ordre de 1N/m, 100µm de longueur, quelques dizaines de micromètres de largeur et quelques micromètres d'épaisseur, ont été développés.

Il est difficile d'envisager des cantilevers plus souples. En effet, leurs dimensions sont difficiles à maîtriser en raison de leur grande longueur vis-à-vis de leur faible largeur et/ou épaisseur. De plus, la précision de positionnement des pointes en regard de la surface du support de mémoire s'en ressentirait, limitant ainsi la densité de la mémoire.

Objet de l'invention

5

20

25

L'invention a pour but un procédé et un dispositif d'enregistrement de données ne présentant pas les inconvénients ci-dessus et permettant plus particulièrement d'ignorer la dispersion dans la hauteur des micro-pointes.

Selon l'invention, ce but est atteint par un procédé et un dispositif selon les revendications annexées.

Un procédé d'enregistrement selon l'invention est plus particulièrement, caractérisé par le fait que, les micropointes étant fixées directement sur un même substrat de support, le procédé comporte, avant l'actionnement sélectif de micropointes pour l'enregistrement de données, la mise en contact, avec une pression prédéterminée, du réseau de micropointes et du support de mémoire, ladite pression permettant l'absorption, par la couche mémoire déformable, de la dispersion des dimensions des micropointes du réseau de micropointes.

Un dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'invention comporte un réseau de micropointes disposé dans un plan face à un support de mémoire, comportant un empilement de couches minces avec au moins une couche mémoire déformable, des moyens d'absorption de la dispersion des dimensions des micropointes du réseau et des moyens d'enregistrement par actionnement sélectif de micropointes. Ce dispositif est caractérisé en ce que la couche mémoire déformable constitue lesdits moyens d'absorption lors de la mise en contact, à ladite pression prédéterminée, du support de mémoire et du réseau de micropointes, les micropointes, de dimension d'apex nanométrique, étant fixées directement sur un même substrat de support.

Description sommaire des dessins

5

15

20

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés au dessin annexé, dans lequel la figure unique illustre schématiquement un mode de réalisation particulier d'un dispositif d'enregistrement de données selon l'invention.

Description d'un mode particulier de réalisation.

Le réseau de micropointes d'un dispositif d'enregistrement de données selon l'invention comporte une pluralité de micropointes 6 fixées directement, c'est-àdire sans cantilever, à un même substrat 7. Les micropointes sont donc solidaires du substrat 7, qui est de préférence rigide.

Avant l'actionnement sélectif des micropointes pour l'enregistrement des données, le substrat 7 de support des micropointes 6 est déplacé en direction du support de mémoire 1, de manière à amener simultanément toutes les micropointes 6 en contact, à une pression prédéterminée, avec le support de mémoire 1. Le support de mémoire 1, déformable, est conçu de manière à absorber la dispersion de hauteur de toutes les micro-pointes 6 solidaires d'un même substrat 7 leur servant de support.

Sur la figure, seulement deux micropointes 6a et 6b, solidaires du substrat 7, sont représentées. Leur différence de hauteur est exagérée sur la figure, de manière à illustrer clairement le principe de fonctionnement du dispositif. Ainsi, tandis que la micropointe 6b vient en contact avec le support de mémoire 1 sans le déformer, la micropointe 6a, plus longue, provoque localement une petite

WO 2005/013270 PCT/FR2004/001677

déformation du support de mémoire 1. La pression exercée par la micropointe la plus longue est alors insuffisante pour provoquer une déformation représentative d'une donnée à enregistrer.

L'enregistrement de données est réalisé ultérieurement, de manière classique, par actionnement sélectif des micropointes. L'actionnement sélectif des micropointes, destiné à l'enregistrement des données, peut être de type thermique, électrostatique, électrique et/ou mécanique, de manière à former des marques (correspondant par exemple à des changements d'état, des déformations, etc.) à des emplacements mémoire présélectionnés. Dans le cas où l'enregistrement provoque sélectivement, par exemple par pression, une déformation locale de la membrane, la pression exercée doit alors être nettement supérieure à la pression exercée par les micropointes lors de la mise en contact des micropointes du réseau et du support de mémoire.

15

10

5

Les déformations de la couche mémoire déformable 1 permettant d'absorber la dispersion des micropointes lors de la mise en contact du réseau de micropointes et du support de mémoire sont beaucoup moins importantes que les marques éventuellement provoquées, thermiquement, électriquement ou mécaniquement, lors de l'enregistrement des données.

20

Comme représenté sur la figure, le support de mémoire 1 est, de préférence, constitué par un empilement de couches minces comportant au moins une couche mémoire déformable déposée sur un substrat 4.

25

La couche mémoire déformable peut être constituée par une couche mémoire souple ou, comme représenté sur la figure, par un empilement d'une couche mémoire 2 et d'une couche souple 3, cette dernière étant déposée sur le substrat 4. Une couche 5, d'interface avec les micro-pointes 6, peut recouvrir la

couche mémoire 2. Lors de la mise en contact du réseau de micropointes et du support de mémoire 1, l'appui d'une micro-pointe 6a sur le support de mémoire 1 se traduit alors par une déformation progressive de l'empilement, jusqu'à la couche souple 3. Cette déformation progressive est fonction de la dureté et de l'épaisseur des différentes couches. La constitution et l'épaisseur des différentes couches de l'empilement sont adaptées aux fonctionnalités recherchées et, en particulier, au mode d'enregistrement choisi (thermique, électrique, etc.).

5

10

15

20

25

La couche souple 3 peut être constituée par une couche de polymère. À titre d'exemple, elle peut être constituée par de la résine photosensible, notamment de la résine photosensible utilisée en microélectronique dans les procédés de détachement de type "liftoff". Elle peut également être constituée par une colle de dureté contrôlée ou par une couche de silicone élastomère de type PDMS. La couche souple 3 est, de préférence, déposée sur le substrat 4 par dépôt tournette ("spin coating") ou par projection ("spray"). Son épaisseur dépend de la souplesse recherchée et peut, par exemple, être de l'ordre de quelques micromètres ou même moins si nécessaire.

Le substrat 4 peut être en silicium ou en matière plastique, éventuellement souple, par exemple en polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Dans ce cas, sa souplesse peut contribuer à la souplesse de l'empilement constituant le support de mémoire 1 et son épaisseur peut être réduite à moins d'un millimètre.

La constitution de la couche mémoire 2 dépend du processus d'enregistrement des données choisi. Cette couche peut notamment être en polymère ou en matériau à changement de phase, isolant ou conducteur. Dans tous les cas, la couche mémoire doit être aussi fine que possible pour conserver la souplesse requise du support de mémoire. Elle a ainsi généralement une épaisseur inférieure au micromètre. Elle peut, par exemple, être déposée par PVD, par

exemple par pulvérisation cathodique, par PECVD ou par dépôt tournette sur la couche souple 3.

Si le processus d'écriture choisi est un processus d'écriture électrique, il peut être nécessaire de rendre conductrice la couche souple 3. Ceci peut notamment être réalisé par le choix d'un matériau polymère conducteur, par l'addition d'un additif dans le matériau initialement isolant ou par interposition d'une couche conductrice additionnelle (non représentée) entre la couche mémoire 2 et la couche souple 3. Une telle couche conductrice additionnelle peut, par exemple, être une couche de carbone, de nature adaptée à la conduction, et de faible épaisseur (quelques dizaines de nanomètres).

5

10

15

La constitution de la couche d'interface 5 est destinée à faciliter l'interaction des micro-pointes 6 et du support de mémoire. À titre d'exemple, la couche d'interface 5 peut être en carbone, en polymère, ... Quelle que soit sa nature, elle devra être aussi fine que possible pour ne pas rigidifier le support de mémoire 1.

WO 2005/013270
9 PCT/FR2004/001677

Revendications

5

10

15

20

25

1. Procédé d'enregistrement de données au moyen d'un réseau de micropointes (6), disposé dans un plan face à un support de mémoire (1), comportant un empilement de couches minces avec au moins une couche mémoire (2) déformable, procédé comportant l'enregistrement de données par actionnement sélectif des micropointes, procédé caractérisé en ce que les micropointes étant fixées directement sur un même substrat de support (7), le procédé comporte, avant l'actionnement sélectif de micropointes pour l'enregistrement de données, la mise en contact, avec une pression prédéterminée, du réseau de micropointes et du support de mémoire, ladite pression permettant l'absorption, par la couche mémoire (2) déformable, de la dispersion des dimensions des micropointes du réseau de micropointes (6).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'enregistrement des données est de type électrique.

- 3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'enregistrement des données est de type thermique.
- 4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'enregistrement des données est réalisé par application d'une pression mécanique supérieure à la pression de mise en contact.

5. Dispositif d'enregistrement pour la mise en œuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, comportant un réseau de micropointes disposé dans un plan face à un support de mémoire, comportant un empilement de couches minces avec au moins une couche mémoire (2) déformable, des

moyens d'absorption de la dispersion des dimensions des micropointes du réseau et des moyens d'enregistrement par actionnement sélectif de micropointes, dispositif caractérisé en ce que la couche mémoire déformable constitue lesdits moyens d'absorption lors de la mise en contact, à ladite pression prédéterminée, du support de mémoire et du réseau de micropointes, les micropointes, de dimension d'apex nanométrique, étant fixées directement sur un même substrat de support (7).

5

10

20

25

- 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que la couche mémoire (2) est déposée sur une couche souple (3), déposée sur le substrat (4).
 - 7. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en polymère.
- 8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en résine photosensible.
 - 9. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la couche souple (3) est une colle de dureté contrôlée.
 - 10. Dispositif selon la revendication 6, caractérisé en ce que la couche souple (3) est en silicone élastomère.
 - 11. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 10, caractérisé en ce que la couche souple (3) a une épaisseur de l'ordre de quelques micromètres.
 - 12. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 11, caractérisé en ce que la couche souple (3) est conductrice.

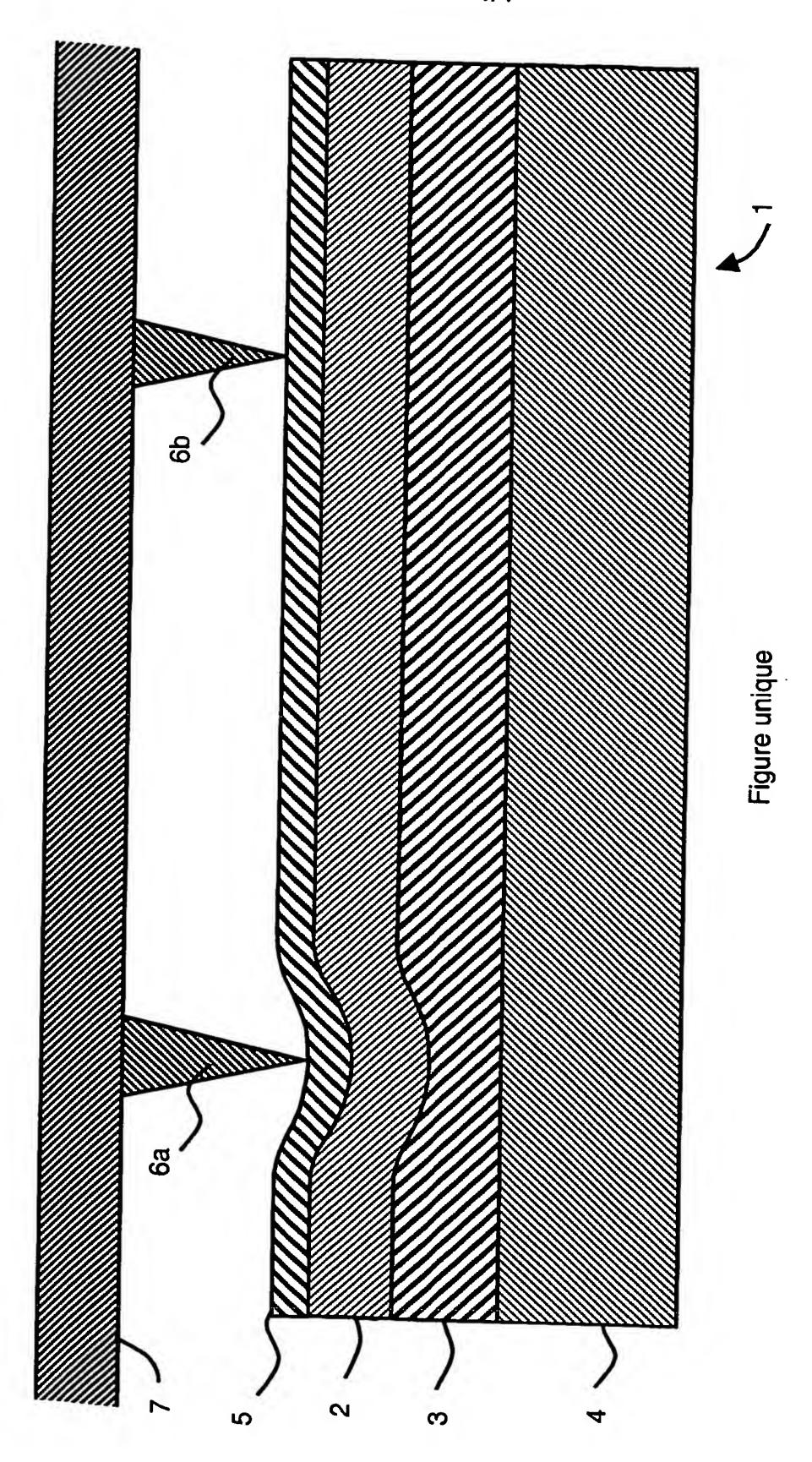
WO 2005/013270 PCT/FR2004/001677

- 13. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 6 à 11, caractérisé en ce qu'il comporte une couche conductrice additionnelle entre la couche mémoire (2) et la couche souple (3).
- 14. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 13, caractérisé en ce que la couche mémoire (2) a une épaisseur inférieure au micromètre.
- 15. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 14, caractérisé en ce qu'il comporte une couche (5) d'interface avec les micro-pointes (6), recouvrant la couche mémoire (2).

5

15

- 16. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 15, caractérisé en ce que le substrat (4) est en silicium.
- 17. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 5 à 16, caractérisé en ce que le substrat (4) est en matière plastique, de moins d'un millimètre d'épaisseur.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

T/FR2004/001677

A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		17 F N 2 U U 4 / U U 1 6 / /
IPC 7	G11B9/00		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national c	lassification and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum d	documentation searched (classification system followed by clas	ssification symbols)	
110 /	G11B	,	
-			
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the exten	t that such documents are included in	the fields searched
Electronic o	data base consulted during the international search (name of d	ata base and where practical accord	
EPO-In	nternal	ame and, where placified, search	i terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of		
	where appropriate, or	ine relevant passages	Relevant to claim No.
Α	WO 02/078005 A (HEWLETT PACKAI	RD CO)	
	3 Uctober 2002 (2002-10-03)		1-17
	page 8, line 29 - page 9, line	e 31; figures	
	4A-5		
Α	WO 97/44780 A (IBM ; DUERIG URS	STHEODOR	
	(cn); AFILIGER LEIFE (CH))	THEODOK	1-17
	$\frac{2}{November 1997 (1997-11-27)}$		
	cited in the application the whole document		
		-/	
		•	
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members	are listed in annex.
Special cate	egories of cited documents :		
A' documer	nt defining the general state of the art which is not	"T" later document published aft or priority date and not in co	Office with the application but
E' earlier do	Ocument but published on or after the international	invention	caple or theory underlying the
L* documen	It which may throw doubte on origin.	"X" document of particular releva cannot be considered nove	IOF CANNOT be concidered to
***********	s cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular releva	ien the document is taken alone
O* documer other m	nt referring to an oral disclosure, use application as	vanisti be considered to inv	olve an inventive step when the one or more other such docu-
P* documen	of published prior to the international filling data but	ments, such combination be in the art.	eing obvious to a person skilled
		"&" document member of the sar	ne patent family
or mie 4(ctual completion of the international search	Date of mailing of the interna	tional search report
	November 2004	26/11/2004	
ame and ma	ailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Hermann, R	
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No T/FR2004/001677

Category °	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	
	with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	VETTIGER P ET AL: "The Millipede-more than one thousand tips for future AFM data storage" IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, IBM CORPORATION, ARMONK, US, vol. 44, no. 3, May 2000 (2000-05), pages 323-340, XP002194187 ISSN: 0018-8646 cited in the application figures 1,2,11,14	1-17
4	US 6 218 086 B1 (BINNIG GERD K ET AL) 17 April 2001 (2001-04-17) cited in the application column 4, line 1 - column 6, line 7; figures 1,4	1-17
	EP 0 887 794 A (HITACHI LTD) 30 December 1998 (1998-12-30) cited in the application column 3, line 51 - column 8, line 24; figures 3-5	11-13, 15-17

IN LEKINA LICINAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
T/FR2004/001677

Potent decument						
Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
W0 02078005	A 	03-10-2002	US EP WO	2002172072 1374246 02078005	A2	21-11-2002 02-01-2004 03-10-2002
WO 9744780	Α	27-11-1997	WO US	9744780 6084849	• • •	27-11-1997 04-07-2000
US 6218086	B1	17-04-2001	WO	2004074765	A1	02-09-2004
EP 0887794	A	30-12-1998	WO EP	9735308 0887794	-	25-09-1997 30-12-1998

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



A. CLA	SSEM	ENT DE L'OBJET DE LA G11B9/00	DEMANDE
CIR	/	G11B9/00	

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 G11B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal

Catégorie °	Identification des documents cités avec le genération des	
	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 02/078005 A (HEWLETT PACKARD CO) 3 octobre 2002 (2002-10-03) page 8, ligne 29 - page 9, ligne 31; figures 4A-5	1-17
A	WO 97/44780 A (IBM ;DUERIG URS THEODOR (CH); VETTIGER PETER (CH)) 27 novembre 1997 (1997-11-27) cité dans la demande le document en entier	1-17
	-/	
		·

X Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
° Catégories spéciales de documents cités:	*T* doormant white

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L' document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée
- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité Inventive par rapport au document considéré isolément
- document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *& document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

19 novembre 2004

26/11/2004

Fonctionnaire autorisé

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk

Hermann, R

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (Janvier 2004)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE



C.(suite) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	ET/FR20	004/001677
Catégorie °		nonto	
		ecuts	no. des revendications visée
A	VETTIGER P ET AL: "The Millipede-more than one thousand tips for future AFM data storage" IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, IBM CORPORATION, ARMONK, US, vol. 44, no. 3, mai 2000 (2000-05), pages 323-340, XP002194187 ISSN: 0018-8646 cité dans la demande figures 1,2,11,14		1-17
A	US 6 218 086 B1 (BINNIG GERD K ET AL) 17 avril 2001 (2001-04-17) cité dans la demande colonne 4, ligne 1 - colonne 6, ligne 7; figures 1,4		1-17
	EP 0 887 794 A (HITACHI LTD) 30 décembre 1998 (1998-12-30) cité dans la demande colonne 3, ligne 51 - colonne 8, ligne 24; figures 3-5		11-13, 15-17
daise DOTTO	/210 (suite de la deuxième feuille) (Janvier 2004)		

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renselgnements rel

ix membres de familles de brevets

Demande Internationale No
T/FR2004/001677

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	. Date de publication
WO 02078005	A	03-10-2002	US EP WO	2002172072 A1 1374246 A2 02078005 A2	21-11-2002 02-01-2004 03-10-2002
W0 9744780	Α	27-11-1997	WO US	9744780 A1 6084849 A	27-11-1997 04-07-2000
US 6218086	B1	17-04-2001	WO	2004074765 A1	02-09-2004
EP 0887794	Α	30-12-1998	WO EP	9735308 A1 0887794 A1	25-09-1997 30-12-1998